

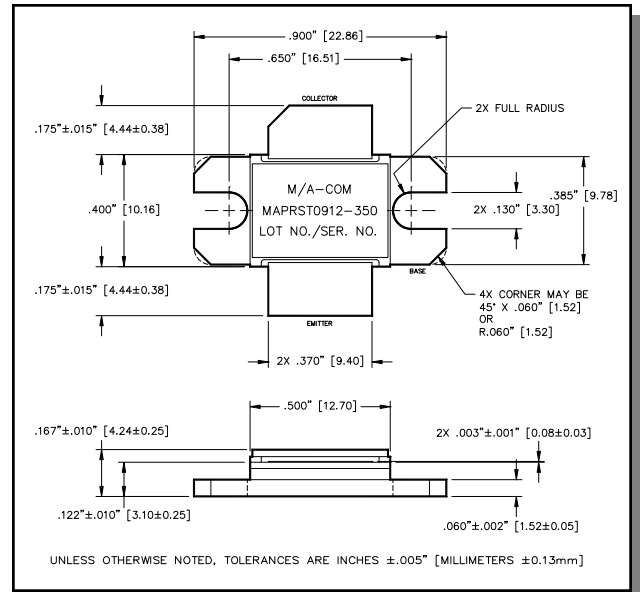
Avionics Pulsed Power Transistor
350W, 960-1215 MHz, 10µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 30 May 07

Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS Compliant

Outline Drawing



Absolute Maximum Ratings at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	65	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	3.0	V
Collector Current (Peak)	I_C	32.5	A
Power Dissipation @ +25°C	P_{TOT}	1.34	kW
Storage Temperature	T_{STG}	-65 to +200	°C
Junction Temperature	T_J	200	°C

Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient)

Parameter	Test Conditions	Frequency	Symbol	Min	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 50\text{mA}$		BV_{CES}	65	-	V
Collector-Emitter Leakage Current	$V_{CE} = 50\text{V}$		I_{CES}	-	15	mA
Thermal Resistance	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 40\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	$R_{TH(JC)}$	-	0.13	°C/W
Output Power	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 40\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	P_O	350	-	W
Power Gain	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 40\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	G_P	9.4	-	dB
Collector Efficiency	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 40\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	η_C	45	-	%
Input Return Loss	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 40\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	RL	-	-9	dB
Load Mismatch Stability	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 40\text{W}$	F = 960 MHz	VSWR-T	-	10:1	-
Load Mismatch Tolerance	$V_{CC} = 50\text{V}$, $P_{in} = 40\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	VSWR-S	-	1.5:1	-

Avionics Pulsed Power Transistor
350W, 960-1215 MHz, 10 μ s Pulse, 10% Duty

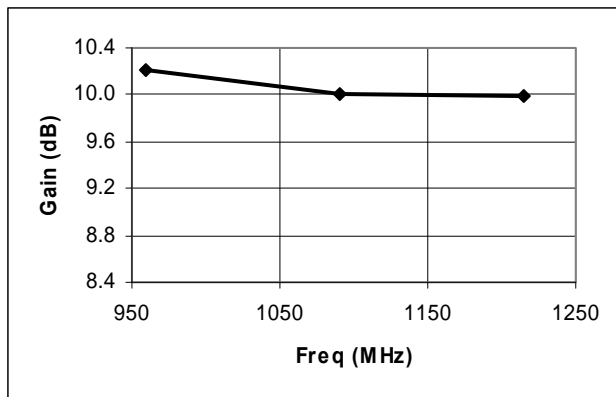
M/A-COM Products
Released, 30 May 07

Typical RF Performance

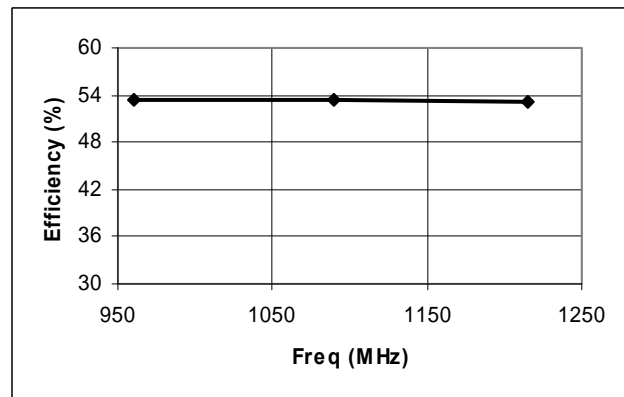
Freq. (MHz)	Pin (W)	Pout (W)	Gain (dB)	Δ Gain (dB)	Ic (A)	Eff (%)	RL (dB)	VSWR-S (1.5:1)	VSWR-T (10:1)	P1dB Overdrive	
										Pout	Δ Po
960	40	421	10.22	-	15.7	53.4	-19.9	S	P	496	0.72
1090	40	401	10.01	-	15.0	53.4	-18.5	S	-	469	0.69
1215	40	399	9.99	0.23	15.0	53.2	-21.5	S	-	421	0.22

Note: Δ Po(dB) is the difference between Pout at 1dB overdrive and Pout at Pin = 40W.

Gain vs. Frequency



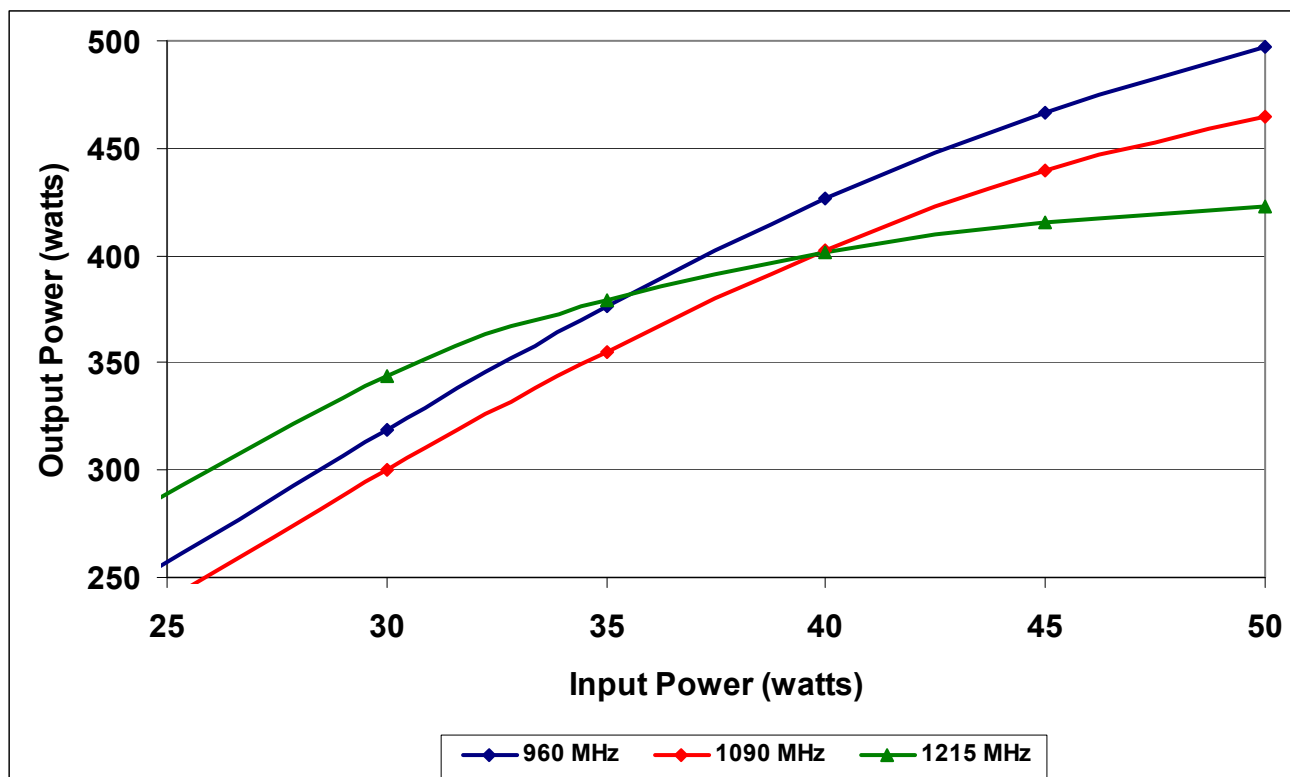
Collector Efficiency vs. Frequency



Avionics Pulsed Power Transistor
350W, 960-1215 MHz, 10 μ s Pulse, 10% Duty

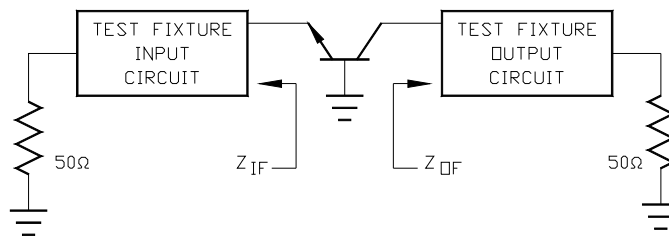
M/A-COM Products
Released, 30 May 07

RF Power Transfer Curve (Output Power Vs. Input Power)



Broadband Test Fixture Impedance

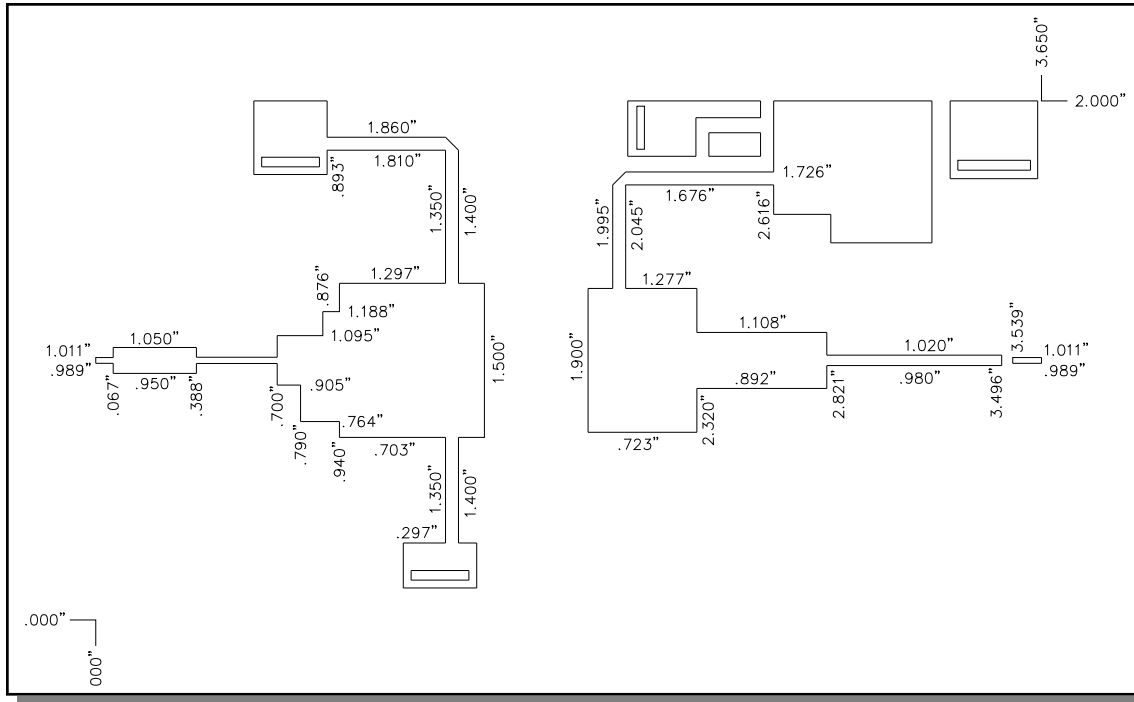
F (MHz)	Z _{IF} (Ω)	Z _{OF} (Ω)
960	1.8 - j1.7	1.7 - j1.7
1030	1.7 - j1.4	1.8 - j1.2
1090	1.6 - j1.2	1.9 - j0.8
1150	1.4 - j1.0	1.9 - j0.6
1215	1.2 - j0.8	2.0 - j0.2



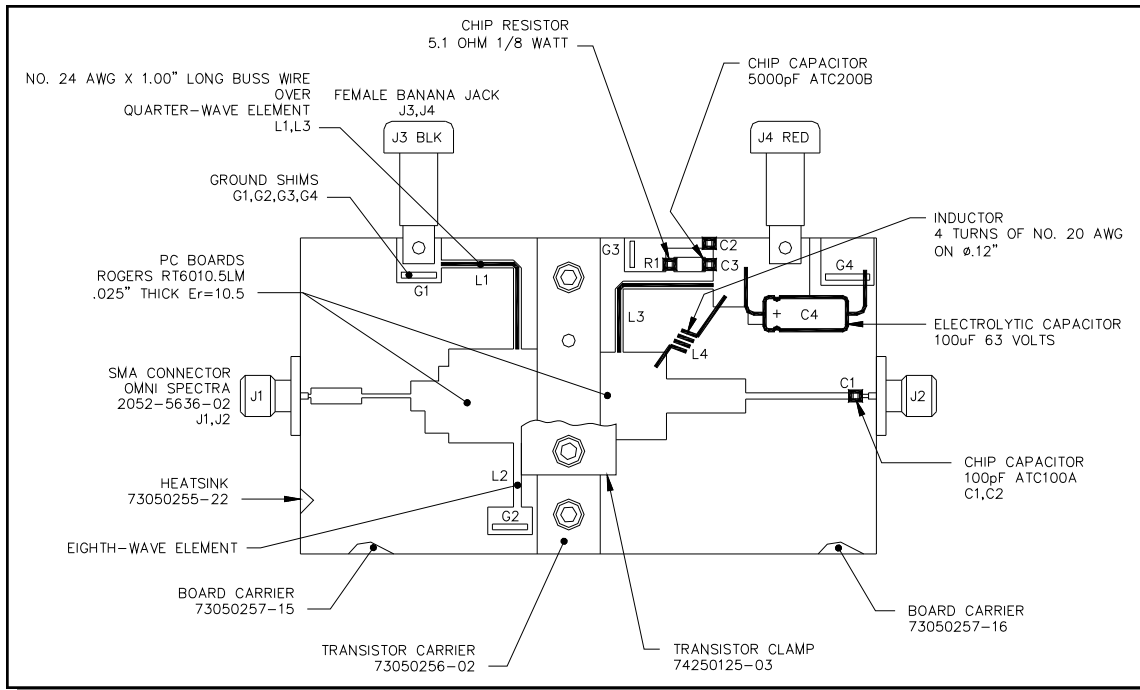
Avionics Pulsed Power Transistor
350W, 960-1215 MHz, 10µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 30 May 07

Test Fixture Circuit Dimensions



Test Fixture Assembly



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9